



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20100830000
2011 年 8 月 17 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

HPA SEMEFAB社サイト製造 一部製品 前処理プロセス変更のご案内

(初版 PCN20100830000 2010 年 9 月 2 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての最終版の連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **30** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。本変更に対するお客様個別のご要求に関しましては、個別契約にて承ります。弊社と合意済みの個別要求につきましては、別途対応させていただきます。担当営業にご確認下さい。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	<input type="checkbox"/> Initial notice (Plan)	<input checked="" type="checkbox"/> Final notice		
変更概要	Design/Specification	<input type="checkbox"/> Design	<input type="checkbox"/> Electrical	<input type="checkbox"/> Mechanical
	<input checked="" type="checkbox"/> Wafer Fab	<input type="checkbox"/> Site	<input checked="" type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Wafer Bump	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Assembly	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Test	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	
	Others	<input type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling	<input type="checkbox"/>	-
変更内容	HPA SEMEFAB 社サイト製造 一部製品 前処理プロセス変更 現行 : 前処理プロセス一部変更 未対応 変更後: 前処理プロセス一部変更 対応			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	9月下旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	<input type="checkbox"/> 計画	<input checked="" type="checkbox"/> 終了		
製品表示	<input checked="" type="checkbox"/> 変更無し	<input type="checkbox"/> 変更あり		
備考	—			

変更内容

内容：弊社 HPA(ハイパフォーマンスアナログ) SEMEFAB社(スコットランド)サイト製造 一部製品について、プロセス最適化及び生産性向上の為に、前処理プロセス一部を変更し認定しました。プロセス変更については下記を参照下さい。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
前処理プロセス	一部変更未対応	一部変更対応

	現行	変更後	変更理由
Process	902 process	Create 904, a sub group of 902	To have both oxide and Nitride caps
Process Sequence	Process sequence for Nitride capacitor only	Process sequence for Nitride and Oxide capacitors	Devices need to have both capacitors
Passivation	ASM passivation dep (14kA)	Oxide (5kA) LTO +OxyNitride (9kA) Novellus	To fix the surface charges

理由：プロセス最適化及び生産性向上の為

対象製品リスト

対象製品名				
ACF2101BU	ACF2101BUE4	IVC102U	IVC102U/2K5	IVC102U/2K5G4

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2011年8月11日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	ACF2101BU		-	-
Wafer Fab Site:	SEMEFAB		Wafer Fab Process:	SEMEFAB 904
Die Protective Coating:	PECVD, Oxide 5kA+OxyNitride 9kA		Metallization:	AlSi
MSL:	JEDEC L-3/260C		-	-
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
**Steady-state Life Test	125C, 1000 Hrs	77/0		
Electrical Characterization	-	Approved		
**High Temp. Storage Bake	150C, 1000 Hrs	77/0		
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hours	77/0		
**Autoclave	121C, 96 Hours	77/0		
**Temp Cycle	-65C/150C, 500 Cycles	77/0		
ESD HBM	350V Note(1)	Approved		
ESD CDM	500V	6/0		
Latchup	-	6/0		
Moisture Sensitivity	JEDEC L-3/260C	12/0		
Notes:				
** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C				
(1) Passes at 350V; this is consistent with historical performance of the device.				

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2011年8月11日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	IVC102U		-	-
Wafer Fab Site:	SEMEFAB		Wafer Fab Process:	SEMEFAB 904
Die Protective Coating:	PECVD, Oxide 5kA + OxyNitride 9kA		Metallization:	AlSi
MSL:	JEDEC L-3/260C		-	-
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot1	Lot2	
**Steady-state Life Test	125C, 1000 Hours	77/0	-	
Electrical Characterization	Full Temperature	Approved	-	
**High Temp. Storage Bake	150C, 1000 Hrs	77/0	77/0	
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hours	77/0	77/0	
**Autoclave	121C, 96 Hours	76/0	77/0	
**Temp Cycle	-65C/150C, 500 Cycles	77/0	77/0	
ESD HBM	500V Note(1)	Approved	-	
ESD CDM	500V	6/0	-	
Latchup	-	6/0	-	
Manufacturability (Wafer Fab)	per mfg. Site specification	Approved	-	
Moisture Sensitivity	JEDEC L-3/260C	12/0	-	
Notes:				
** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C				
(1) Passes at 500V; this is consistent with historical performance of the device.				